

# Germanium PNP Transistor


## **GC122**

35V / 250mA

# DATASHEET

OEM – RFT

Source: RFT Datenbuch Germanium Transistoren 71/72



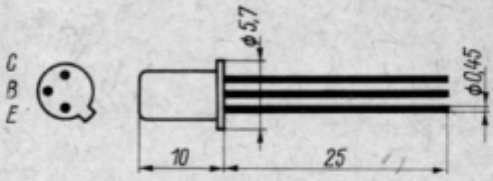
**RFT**  
electronic

## GC 122

---

Germanium-pnp-Transistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 für Niederfrequenz mit erhöhter Spannungsfestigkeit.

---




Masse ca. 0,8 g

---

**Grenzwerte**

Kollektor-Basis-Spannung		$-U_{CBO} = 35 \text{ V}$
Kollektor-Emitter-Spannung		$-U_{CER} = 33 \text{ V}$
$R_{BE} = 1 \text{ k}\Omega$		
Emitter-Basis-Spannung		$-U_{EBO} = 15 \text{ V}$
Kollektorstrom		$-I_{CL} = 250 \text{ mA}$
Basisstrom		$-I_{BL} = 50 \text{ mA}$
Sperrschichttemperatur		$\vartheta_{JL} = +80 \text{ }^\circ\text{C}$
Umgebungstemperatur		$\vartheta_{aL} = -25 \text{ }^\circ\text{C bis } +55 \text{ }^\circ\text{C}$
Wärmewiderstand		$R_{thja} \leq 0,38 \text{ grd/mW}$
Wärmewiderstand		$R_{thjc} \leq 0,05 \text{ grd/mW}$

---



**KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)**  
Stammbetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

8.69  
35

<b>GC 122</b>		<b>RFT</b> electronic		
<b>Statische Kennwerte</b>		Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom $-U_{CB} = 15\text{ V}$	$-I_{CBO}$		$9\ \mu\text{A}$	$18\ \mu\text{A}$
Kollektor-Emitter-Reststrom $-U_{CER} = 33\text{ V}$ $R_{BE} = 1\text{ k}\Omega$	$-I_{CER}$			$100\ \mu\text{A}$
Emitter-Basis-Reststrom $-U_{EB} = 10\text{ V}$	$-I_{EBO}$		$15\ \mu\text{A}$	$50\ \mu\text{A}$
<b>Dynamische Kennwerte</b>				
Grenzfrequenz $-U_{CE} = 2\text{ V}$ $I_C = 10\text{ mA}$	$f_{h_{21e}}$		$12\text{ kHz}$	
Kurzschlußstromverstärkung $-U_{CE} = 0,5\text{ V}$ $-I_C = 100\text{ mA}$	$h_{21E}$	18 28 45 71		35 56 90 140
$h_{21E}$ -Verhältnis	$\frac{h_{21E\ 100}}{h_{21E\ 250}}$		1,3	
$h_{21E\ 100}$ bei $-I_C = 100\text{ mA}$				
$h_{21E\ 250}$ bei $-I_C = 250\text{ mA}$				
Bestellbeispiel für einen Transistor <sup>1</sup> der Stromverstärkungsgruppe B		Transistor GC 122 B		
8.69 36	KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER) Stambetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)			

